

LMK1C110x-Q1 1.8V/2.5V/3.3V 低ノイズ LVCMOS クロック バッファ ファミリ

1 特長

- 高性能の 1:2、1:4、1:6 と 1:8 LVCMOS クロック バッファ
- 超低出力スキュー
 - LMK1C1102-Q1 と LMK1C1104-Q1
 - < 50ps
 - LMK1C1106-Q1 と LMK1C1108-Q1
 - < 55ps
- 非常に小さい追加ジッタ:
 - LMK1C1102-Q1 と LMK1C1104-Q1
 - $V_{DD} = 3.3V$ で標準値 7.5fs
 - $V_{DD} = 2.5V$ で標準値 10fs
 - $V_{DD} = 1.8V$ で標準値 19.2fs
 - LMK1C1106-Q1 と LMK1C1108-Q1
 - $V_{DD} = 3.3V$ で標準値 12fs
 - $V_{DD} = 2.5V$ で標準値 15fs
 - $V_{DD} = 1.8V$ で標準値 28fs
- 超低速伝播遅延: 3ns 未満
- 同期出力イネーブル
- 電源電圧: 3.3V、2.5V、または 1.8V
 - 3.3V トレラント入力機能 (すべての電源電圧で対応)
 - フェイルセーフ入力
- 3.3V で $f_{max} = 250MHz$
2.5V および 1.8V で $f_{max} = 200MHz$
- 車載用グレード 1 (-40°C ~ 125°C)
- AEC-Q100 認定済み
- 利用可能なバージョン:
 - 14 ピンおよび 16 ピンの TSSOP パッケージ
 - 8 ピン WSON パッケージ

2 アプリケーション

- 車載用
 - 先進運転支援システム (ADAS)
 - インフォテインメント / クラスタ
 - レーダー

3 説明

LMK1C110x-Q1 は、テキサス インストルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。5 種類のファンアウト バリエーション 1:2、1:3、1:4、1:6 と 1:8 が利用可能です。

ファミリのすべての製品は、小さい付加ジッタ、小さいスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。

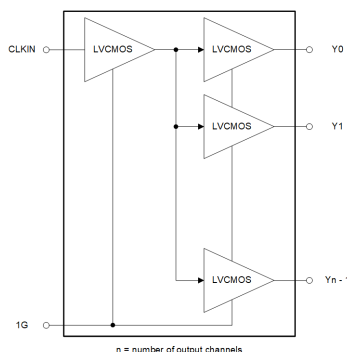
LMK1C110x-Q1 は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。

LMK1C110x-Q1 ファミリは車載用グレード 1 (-40°C から 125°C ~) および AEC-Q100 認定済みで供給されます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
LMK1C1106-Q1	PW (TSSOP, 14)	5.00mm × 4.40mm
LMK1C1108-Q1	PW (TSSOP, 16)	
LMK1C1102-Q1 (3)	DQF (WSON, 8)	2.00mm × 2.00mm
LMK1C1104-Q1 (3)		

- (1) 詳細については、[セクション 12](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) プレビュー版のみ。詳細は テキサス・インストルメンツまでお問い合わせください。



機能ブロック図



目次

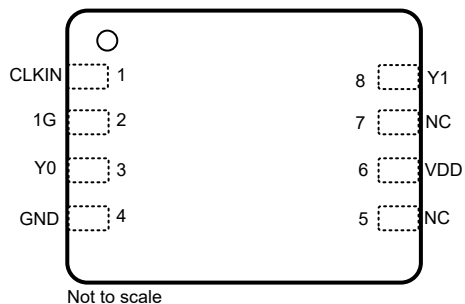
1 特長.....	1	8.4 デバイスの機能モード.....	15
2 アプリケーション.....	1	9 アプリケーションと実装.....	16
3 説明.....	1	9.1 使用上の注意.....	16
4 デバイスの比較.....	3	9.2 代表的なアプリケーション.....	16
5 ピン構成および機能.....	4	9.3 電源に関する推奨事項.....	18
6 仕様.....	6	9.4 レイアウト.....	18
6.1 絶対最大定格.....	6	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	20
6.2 ESD 定格.....	6	10.1 ドキュメントのサポート.....	20
6.3 推奨動作条件.....	6	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	20
6.4 熱に関する情報.....	6	10.3 サポート・リソース.....	20
6.5 電気的特性.....	7	10.4 商標.....	20
6.6 タイミング要件.....	9	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	20
6.7 代表的特性.....	9	10.6 用語集.....	20
7 パラメータ測定情報.....	12	11 改訂履歴.....	20
8 詳細説明.....	14	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	20
8.1 概要.....	14	12.1 パッケージ情報.....	21
8.2 機能ブロック図.....	14	12.2 テープおよびリール情報.....	22
8.3 機能説明.....	15		

4 デバイスの比較

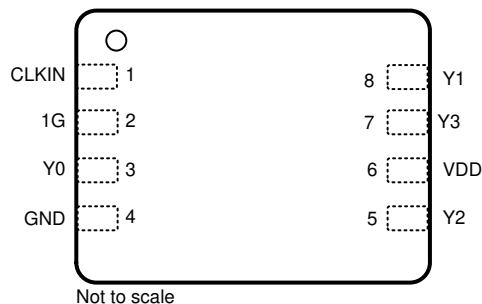
デバイス	入力	出力	出力イネーブル オプション (1G)	パッケージ
LMK1C1102	1	2	同期	WSON (8)、2.00mm × 2.00mm
LMK1C1104	1	4	同期	WSON (8)、2.00mm × 2.00mm
LMK1C1102	1	2	同期	TSSOP (8)、3.00mm × 4.40mm
LMK1C1103	1	3	同期	TSSOP (8)、3.00mm × 4.40mm
LMK1C1104	1	4	同期	TSSOP (8)、3.00mm × 4.40mm
LMK1C1106	1	6	同期	TSSOP (14)、5.00mm × 4.40mm
LMK1C1108	1	8	同期	TSSOP (16)、5.00mm × 4.40mm
LMK1C1102-Q1 ⁽¹⁾	1	2	同期	WSON (8)、2.00mm × 2.00mm
LMK1C1104-Q1 ⁽¹⁾	1	4	同期	WSON (8)、2.00mm × 2.00mm
LMK1C1106-Q1	1	6	同期	TSSOP (14)、5.00mm × 4.40mm
LMK1C1108-Q1	1	8	同期	TSSOP (16)、5.00mm × 4.40mm

(1) プレビュー版のみ。このデバイスの詳細については、TI にご連絡ください。

5 ピン構成および機能



1. DQF (WSO) パッケージは、他のベンダの DFN パッケージと同等です。



1. DQF (WSO) パッケージは、他のベンダの DFN パッケージと同等です。

図 5-1. LMK1C1102-Q1, 8 ピン DQF WSON パッケージ (上面図)

図 5-2. LMK1C1104-Q1, 8 ピン DQF WSON パッケージ (上面図)

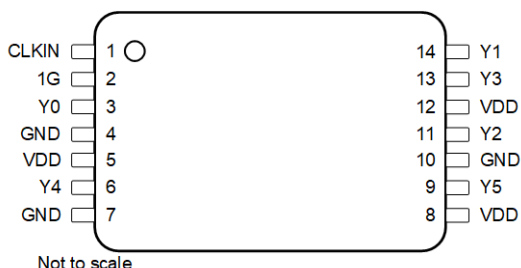


図 5-3. LMK1C1106-Q1, 14 ピン PW TSSOP パッケージ (上面図)

図 5-4. LMK1C1108-Q1, 16 ピン PW TSSOP パッケージ (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン				タイプ ⁽¹⁾	説明
LMK1C 1102-Q1	LMK1C 1104-Q1	LMK1C 1106-Q1	LMK1C 1108-Q1		
LVCMOS クロック入力					
1	1	1	1	I	シングルエンド クロック入力、GND への内部 300kΩ (標準値) プルダウン抵抗付き。通常、シングルエンド クロック入力に接続します。
クロック出力イネーブル					
2	2	2	2	I	グローバル出力イネーブルと GND への内部 300kΩ (標準値) プルダウン抵抗。通常、外付けプルアップ抵抗を使用して VDD に接続します。 HIGH: 出力イネーブル LOW: 出力ディセーブル
LVCMOS クロック 出力					
3	3	3	3	O	LVCMOS 出力。通常はレシーバに接続します。未使用の出力はフローティングのままにできます。
8	8	14	16		
—	5	11	13		
—	7	13	15		
—	—	6	6		
—	—	9	11		
—	—	—	8		
—	—	—	9		
電源電圧					

表 5-1. ピンの機能 (続き)

ピン				タイプ ⁽¹⁾	説明
LMK1C 1102-Q1	LMK1C 1104-Q1	LMK1C 1106-Q1	LMK1C 1108-Q1		
6	6	5	5	P	電源端子。通常、3.3V、2.5V、または 1.8V の電源に接続します。VDD ピンは通常、このピンに近接した外付け 0.1μF コンデンサに接続します。
		8	10		
		12	14		
グラウンド					
4	4	4	4	GND	電源グラウンド。
		7	7		
		10	12		

(1) I = 入力、O = 出力、GND = グラウンド

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲超 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{DD}	電源電圧	-0.5	3.6	V
V _{CLKIN}	入力電圧 (CLKIN)			
V _{IN}	入力電圧 (1G)			
V _{Yn}	出力ピン (Yn)	-0.5	V _{DD} + 0.3	
I _{IN}	入力電流	-20	20	mA
I _O	連続出力電流	-50	50	mA
T _{stg}	保存温度	-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用情况、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC - Q100-002 準拠 ⁽¹⁾	±9000	V
V _(ESD)	静電放電	デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-0111 準拠	±1500	V

(1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称値	最大値	単位
V _{DD}	コア電源電圧	3.3V 電源	3.135	3.3	3.465	V
		2.5V 電源	2.375	2.5	2.625	
		1.8V 電源	1.71	1.8	1.89	
T _A	外気温度での動作時		-40		125	°C
T _J	動作時接合部温度		-40		150	°C

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		LMK1C1102-Q1、 LMK1C1104-Q1、 LMK1C1103-Q1	LMK1C1106-Q1	LMK1C1108-Q1	単位
		PW (TSSOP)	PW (TSSOP)	PW (TSSOP)	
		8 ピン	14 ピン	16 ピン	
R _{qJA}	接合部から周囲への熱抵抗	181.9	114.4	123.4	°C/W
R _{qJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	76.6	45.2	53.1	°C/W
R _{qJB}	接合部から基板への熱抵抗	111.6	60.6	66.4	°C/W
Y _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	16	5.9	8.9	°C/W
Y _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	110.1	60	65.8	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

6.5 電気的特性

VDD = 3.3V±5%、-40°C ≤ TA ≤ 125°C。標準値は、VDD = 3.3V、25°C のときです (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
消費電流						
I _{DD}	コア消費電流、静的	すべて出力がディセーブル、f _{IN} = 0V		25	45	μA
I _{DD}	コア消費電流	すべて出力がディセーブル、f _{IN} = 100MHz、V _{DD} = 1.8V		2	6	mA
I _{DD}	コア消費電流	すべて出力がディセーブル、f _{IN} = 100MHz、V _{DD} = 2.5V		6.5	10	mA
I _{DD}	コア消費電流	すべて出力がディセーブル、f _{IN} = 100MHz、V _{DD} = 3.3V		15	21	mA
I _{DD}	出力電流	出力あたり、f _{IN} = 100MHz、C _L = 5pF、V _{DD} = 1.8V		3.2	3.5	
		出力あたり、f _{IN} = 100MHz、C _L = 5pF、V _{DD} = 2.5V		4.6	5.5	
		出力あたり、f _{IN} = 100MHz、C _L = 5pF、V _{DD} = 3.3V		6	7	
クロック入力						
f _{IN_SE}	入力周波数	V _{DD} = 3.3V	DC		250	MHz
		V _{DD} = 2.5V および 1.8V	DC		200	
V _{IH}	入力 High 電圧		0.7 × V _{DD}			V
V _{IL}	入力 Low 電圧			0.3 × V _{DD}		
dV _{IN} /dt	入力スルーレート	入力スイングの 20% ～ 80%	0.1			V/ns
I _{IN_LEAK}	入力リーク電流		-50		50	μA
C _{IN_SE}	入力容量	25°C で		7		pF
すべての V _{DD} レベルのクロック出力						
f _{OUT}	出力周波数	V _{DD} = 3.3V			250	MHz
		V _{DD} = 2.5V および 1.8V			200	
ODC	出力デューティ サイクル	50% デューティ サイクル入力	45		55	%
t _{1G_ON}	出力イネーブル時間	(1) を参照			5	サイクル
t _{1G_OFF}	出力ディスエーブル時間	(2) を参照			5	サイクル
V _{DD} = 3.3V±5% のクロック出力						
V _{OH}	出力 HIGH 電圧	I _{OH} = 1mA	2.8			V
V _{OL}	出力 LOW 電圧	I _{OL} = 1mA			0.2	
t _{RISE-FALL}	出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間	20/80%、C _L = 5pF、f _{IN} = 156.25MHz		0.3	0.7	ns
t _{OUTPUT-SKEW}	出力間スキュー	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1。(3) を参照		25	50	ps
t _{OUTPUT-SKEW}	出力間スキュー	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1。(3) を参照		25	50	ps
t _{PART-SKEW}	部品間スキュー	LMK1C1102、LMK1C1103、LMK1C1104			250	ps
t _{PART-SKEW}	部品間スキュー	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1			280	ps
t _{PROP-DELAY}	伝搬遅延	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1。(4) を参照		1.5	2	ns
t _{PROP-DELAY}	伝搬遅延	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1。(4) を参照		1.5	2.2	ns

LMK1C1106-Q1, LMK1C1108-Q1

JADS062 – JANUARY 2026

VDD = 3.3V±5%、-40°C ≤ TA ≤ 125°C。標準値は、VDD = 3.3V、25°C のときです (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t _{JITTER-ADD}	付加ジッタ	f _{IN} = 156.25MHz、入力スルーレート = 1.6V/ns、積分範囲 = 12kHz ~ 20MHz		12	20	fs、RMS
R _{OUT}	出力インピーダンス			50		Ω
V _{DD} = 2.5V±5% のクロック出力						
V _{OH}	出力 HIGH 電圧	I _{OH} = 1mA	0.8 × V _{DD}		V	
V _{OL}	出力 LOW 電圧	I _{OL} = 1mA	0.2 × V _{DD}			
t _{RISE-FALL}	出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間	20/80%、C _L = 5pF、f _{IN} = 156.25MHz		0.33	0.8	ns
t _{OUTPUT-SKEW}	出力間スキュー	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1。 ⁽³⁾ を参照			50	ps
t _{OUTPUT-SKEW}	出力間スキュー	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1。 ⁽³⁾ を参照			55	ps
t _{PART-SKEW}	部品間スキュー	LMK1C1102、LMK1C1103、LMK1C1104			400	ps
t _{PART-SKEW}	部品間スキュー	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1			450	ps
t _{PROP-DELAY}	伝搬遅延	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1。 ⁽⁴⁾ を参照		1.5	2.5	ns
t _{PROP-DELAY}	伝搬遅延	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1。 ⁽⁴⁾ を参照		1.5	2.5	
t _{JITTER-ADD}	付加ジッタ	f _{IN} = 156.25MHz、入力スルーレート = 1.2V/ns、積分範囲 = 12kHz ~ 20MHz		15	27	fs、RMS
R _{OUT}	出力インピーダンス			55		Ω
V _{DD} = 1.8V±5% のクロック出力						
V _{OH}	出力 HIGH 電圧	I _{OH} = 1mA	0.8 × V _{DD}		V	
V _{OL}	出力 LOW 電圧	I _{OL} = 1mA	0.2 × V _{DD}			
t _{RISE-FALL}	出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間	20/80%、C _L = 5pF、f _{IN} = 156.25MHz		0.38	1	ns
t _{OUTPUT-SKEW}	出力間スキュー	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1。 ⁽³⁾ を参照			50	ps
t _{OUTPUT-SKEW}	出力間スキュー	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1。 ⁽³⁾ を参照			55	ps
t _{PART-SKEW}	部品間スキュー	LMK1C1102、LMK1C1103、LMK1C1104			900	ps
t _{PART-SKEW}	部品間スキュー	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1			930	ps
t _{PROP-DELAY}	伝搬遅延	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1。 ⁽⁴⁾ を参照		1.5	3	ns
t _{PROP-DELAY}	伝搬遅延	LMK1C1106-Q1、LMK1C1108-Q1。 ⁽⁴⁾ を参照		1.5	3	ns
t _{JITTER-ADD}	付加ジッタ	f _{IN} = 156.25MHz、入力スルーレート = 1.2V/ns、積分範囲 = 12kHz ~ 20MHz		28	60	fs、RMS
R _{OUT}	出力インピーダンス			64		Ω
汎用入力 (1G)						
V _{IH}	High レベル入力電圧		0.75x V _{DD}		V	
V _{IL}	Low レベル入力電圧	LMK1C1102-Q1、LMK1C1103-Q1、LMK1C1104-Q1	0.38 × V _{DD}			

VDD = 3.3V±5%、-40°C ≤ TA ≤ 125°C。標準値は、VDD = 3.3V、25°C のときです (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{IL}	Low レベル入力電圧	LMK1C1106-Q1, LMK1C1108-Q1			0.25 × V _{DD}	V
I _{IH}	入力 high レベル電流	V _{IH} = V _{DD_REF}	-50		50	μA
I _{IL}	入力 LOW レベル電流	V _{IL} = GND	-50		50	

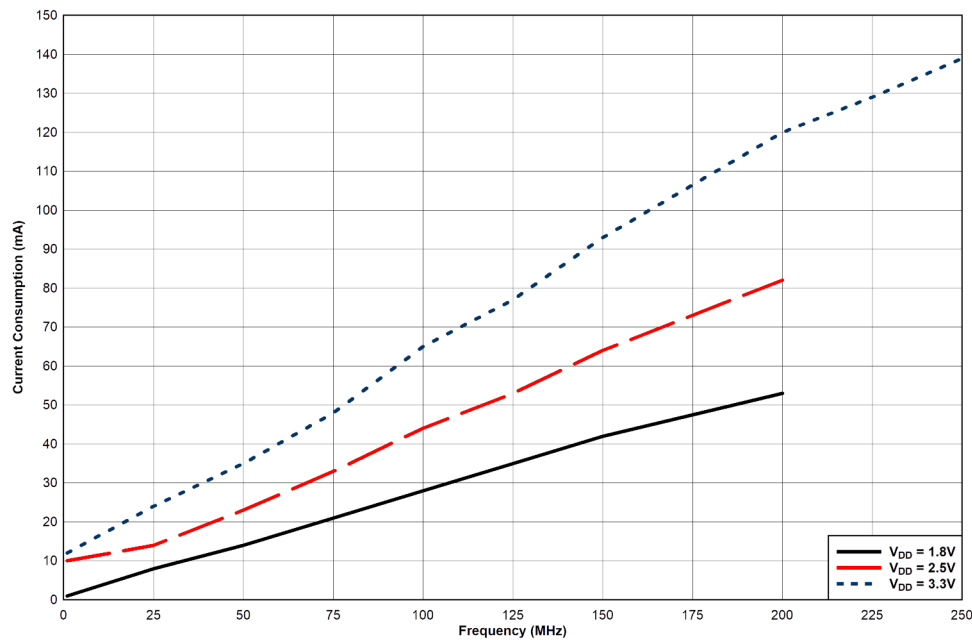
- (1) V_{IH} を交差させる 1G 立ち上がりエッジから Y_n の最初の立ち上がりエッジまでを測定。
- (2) V_{IL} を交差させた 1G 立ち下がりエッジから Y_n の最後の立ち下がりエッジまでを測定。
- (3) 任意の Y_n 出力の立ち上がりエッジから、他の Y_m 出力との間で測定。
- (4) CLKIN の立ち上がりエッジから、任意の Y_n 出力まで測定。

6.6 タイミング要件

VDD = 3.3V ± 5%、-40°C ≤ TA ≤ 125°C

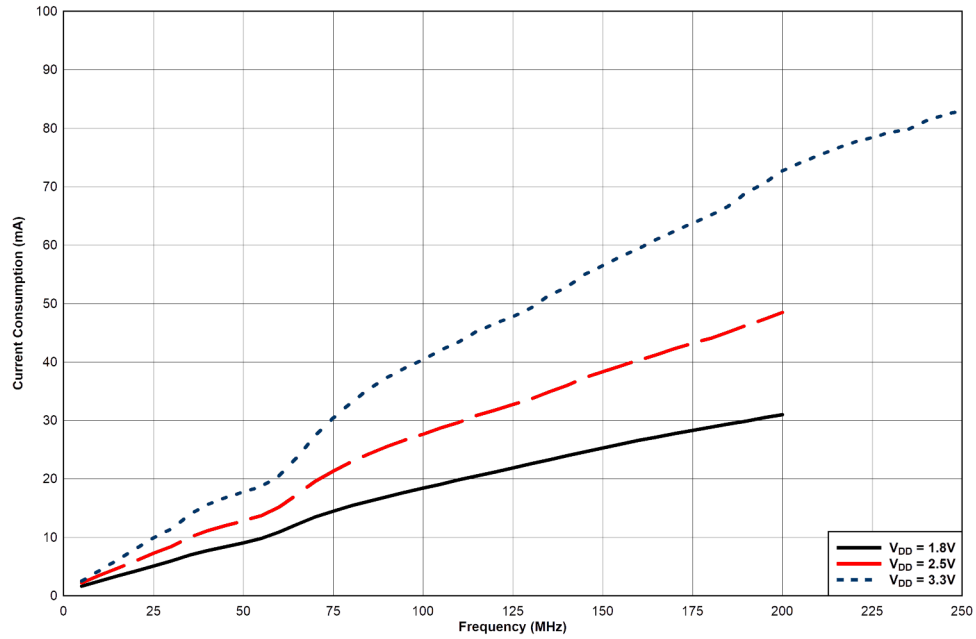
		最小値	公称値	最大値	単位
電源					
V/t _{RAMP}	V _{DD} ランプレート	0.1		50	V/ms

6.7 代表的特性



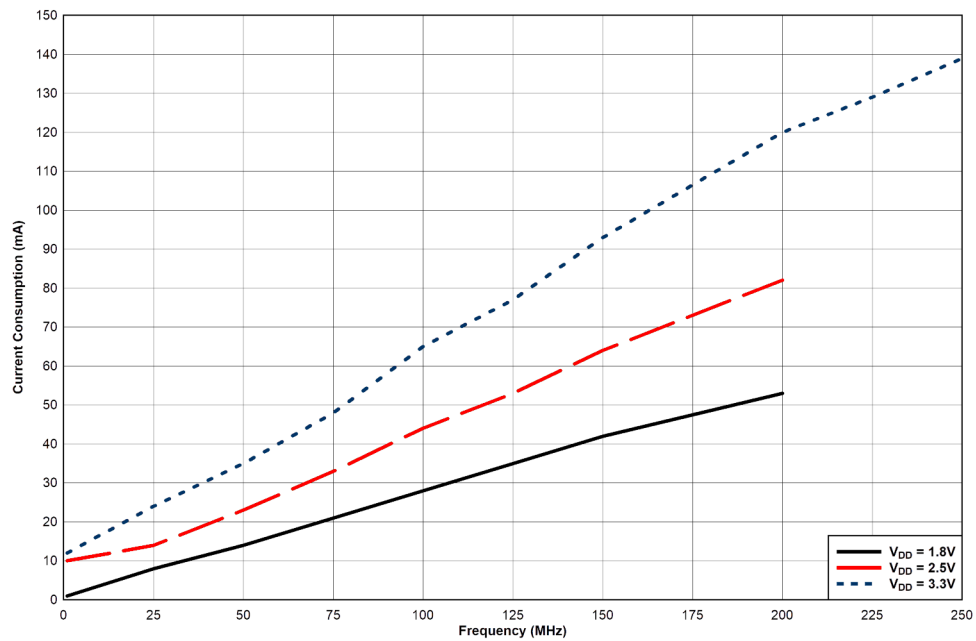
1. すべての出力がイネーブル。

図 6-1. LMK1C1106-Q1 および LMK1C1108-Q1 デバイスの消費電力とクロック周波数との関係 (負荷 5pF)



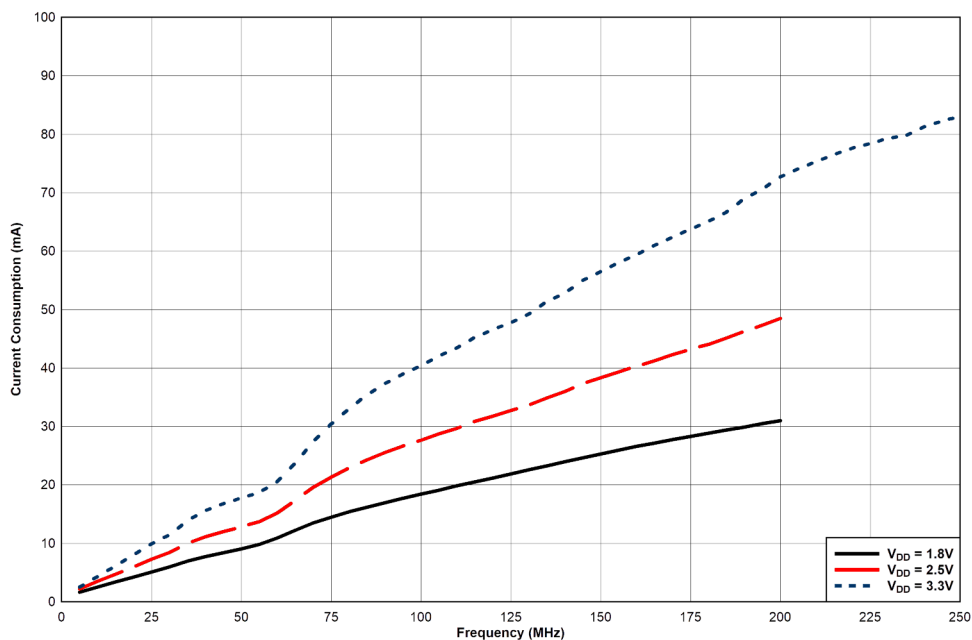
1. すべての出力がイネーブル。

図 6-2. LMK1C1102-Q1 および LMK1C1104-Q1 デバイスの消費電力とクロック周波数との関係 (負荷 5pF)



1. すべての出力がイネーブル。

図 6-3. LMK1C1106-Q1 および LMK1C1108-Q1 デバイスの消費電力とクロック周波数との関係 (負荷 5pF)



1. すべての出力がイネーブル。

図 6-4. LMK1C1102-Q1 および LMK1C1104-Q1 デバイスの消費電力とクロック周波数との関係 (負荷 5pF)

7 パラメータ測定情報

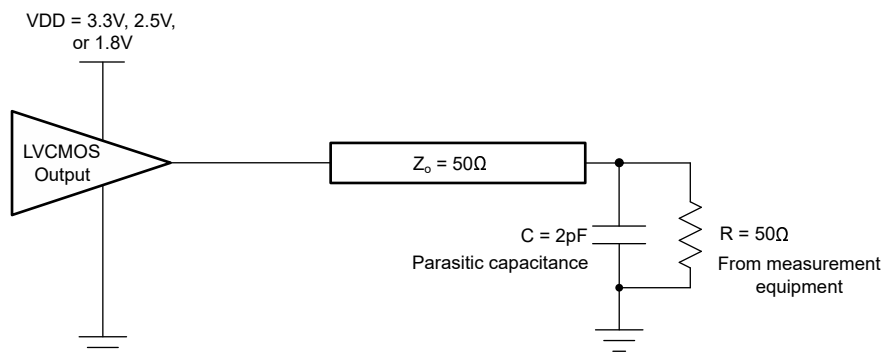


図 7-1. テスト負荷回路

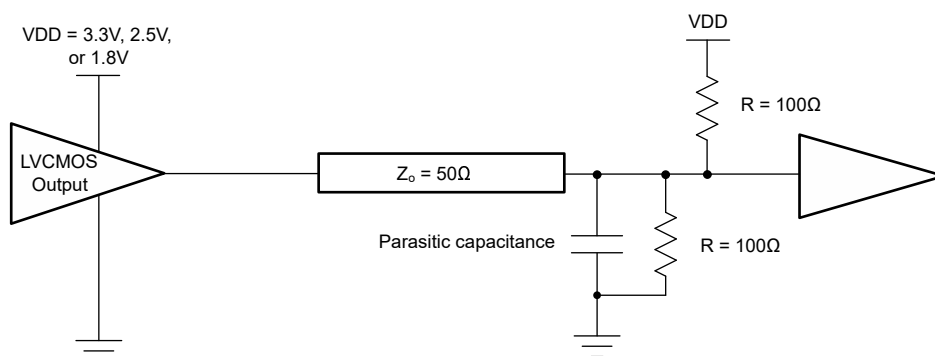


図 7-2. 50Ω 終端のアプリケーション負荷

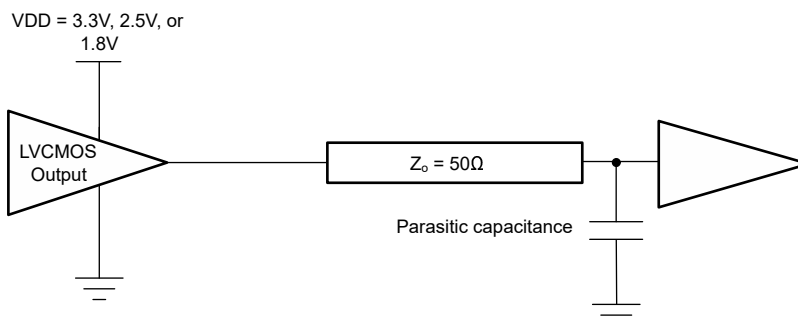


図 7-3. 終端ありのアプリケーション ロード

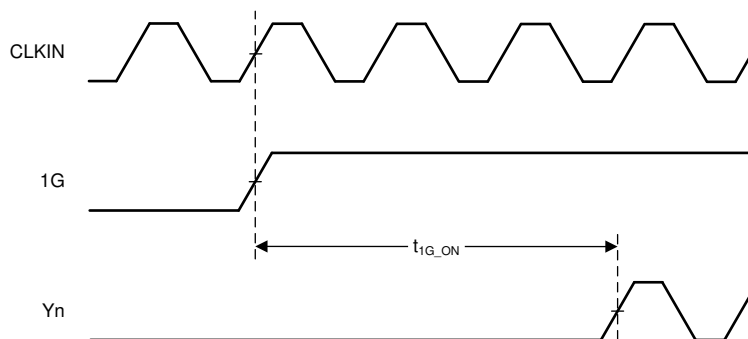


図 7-4. t_{1G_ON} 出力イネーブル時間

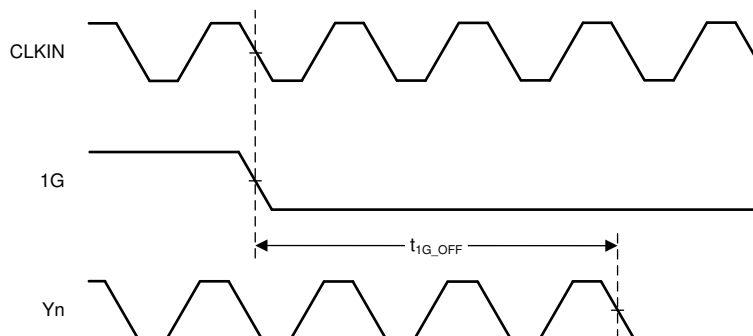


図 7-5. t_{1G_OFF} 出力ディスエーブル時間

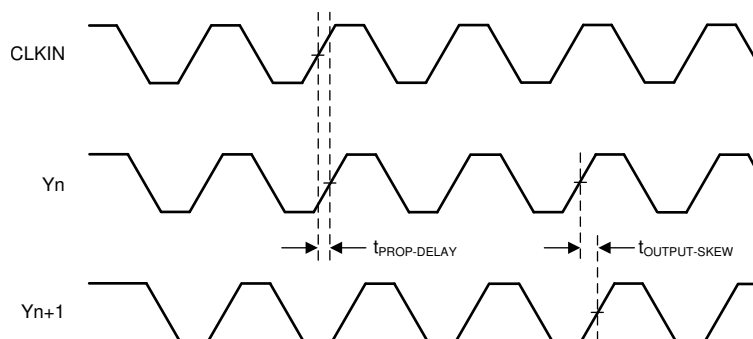


図 7-6. 伝搬遅延 $t_{PROP-DELAY}$ と出力スキュー $t_{OUTPUT-SKEW}$

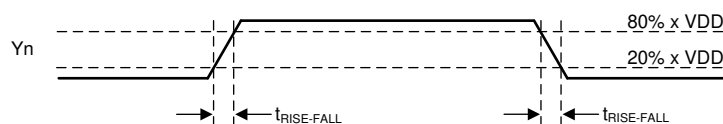


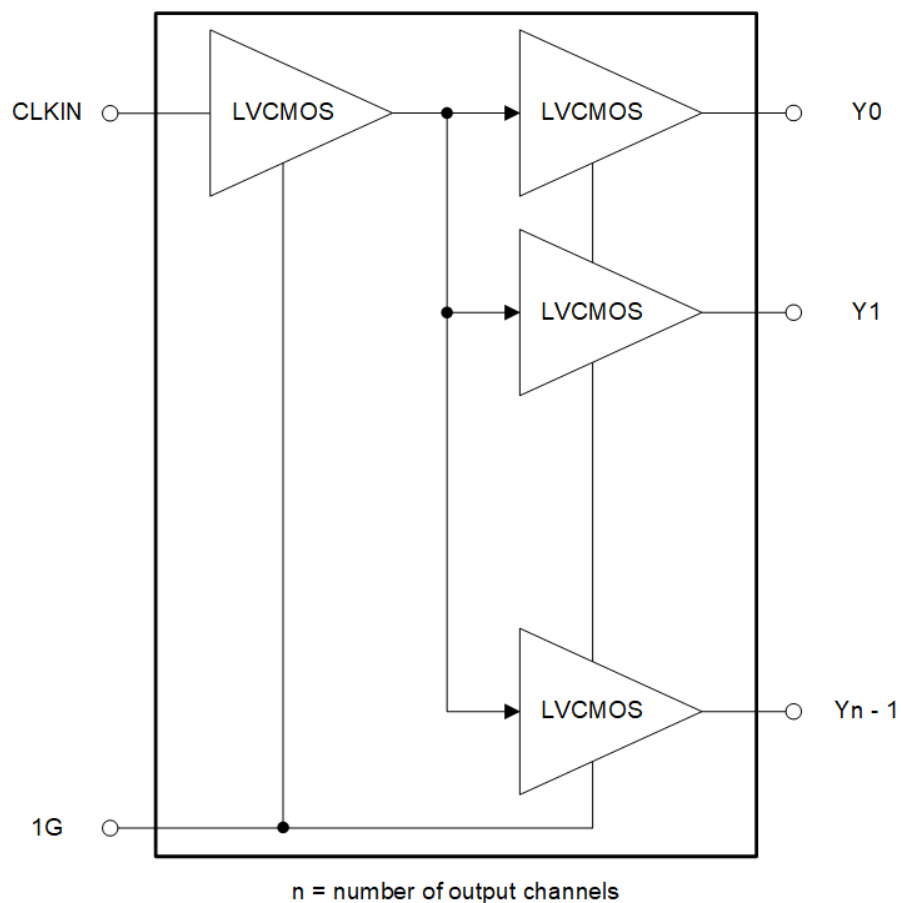
図 7-7. 立ち上がり / 立ち下がり時間 $t_{RISE-TFALL}$

8 詳細説明

8.1 概要

LMK1C110x-Q1 ファミリのデバイスは、低ジッタで低スキューの LVCMOS ファンアウト バッファ ソリューションの製品です。LMK1C110x-Q1 出力ドライバの特性インピーダンスと、伝送ドライバの特性インピーダンスの一致は、最高の信号インテグリティを実現するため重要です。

8.2 機能ブロック図



8.3 機能説明

LMK1C110x-Q1 は、同期出力イネーブル ピン (1G) を Low に駆動することでディセーブルできます。未使用の出力はフローティングのままにして、全体的な部品コストを削減できます。電源ピンとグランド ピンは、それぞれ V_{DD} と GND に接続する必要があります。

8.3.1 フェイルセーフ入力

LMK1C110x-Q1 ファミリのデバイスは、フェイルセーフ入力動作をサポートするよう設計されています。この機能により、VDD が印加される前に、デバイスを損傷することなくデバイス入力を駆動できます。デバイスでサポートされる最大入力の詳細については、「絶対最大定格」を参照してください。このデバイスには入力ヒステリシスも組み込まれており、入力信号が存在しない場合にランダムな発振を防止し、入力ピンをオープンのままにできます。

8.3.2 同期出力イネーブル

同期出力イネーブルにより、出力が有効になる前に、すべての出力クロックが確実に同期されます。高速クロック入力では、非同期出力イネーブルによってグリッチに遅延を追加することは困難です。同期出力イネーブルにより、出力をクロック入力と同期させることで、グリッチレス出力イネーブルが得られます。テキサス インストルメンツから利用可能な出力イネーブル オプションについては、[セクション 4](#) を参照してください。

8.4 デバイスの機能モード

LMK1C110x-Q1 は 1.8V、2.5V、3.3V 電源で動作します。[表 8-1](#) に、LMK1C110x-Q1 の出力論理を示します。同期出力イネーブル ピンでは、出力が入力の「L」ロジックと「H」ロジックに追従するためにクロック エッジが必要です。

表 8-1. 出力論理表

入力		出力
CLKIN	1G	Yn
X	L	L
L	H	L
H	H	H

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーションのセクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 使用上の注意

LMK1C110x-Q1 ファミリは低追加ジッタの LVCMOS バッファの設計であり、 $V_{DD} = 3.3V$ では 250MHz、 $V_{DD} = 2.5V$ 、 $1.8V$ で 200MHz まで動作できます。アプリケーションで必要に応じて、低い出力スキューと、同期出力イネーブルを備えており、バッファ付きクロック出力を同時にイネーブルまたはディセーブルできます。

9.2 代表的なアプリケーション

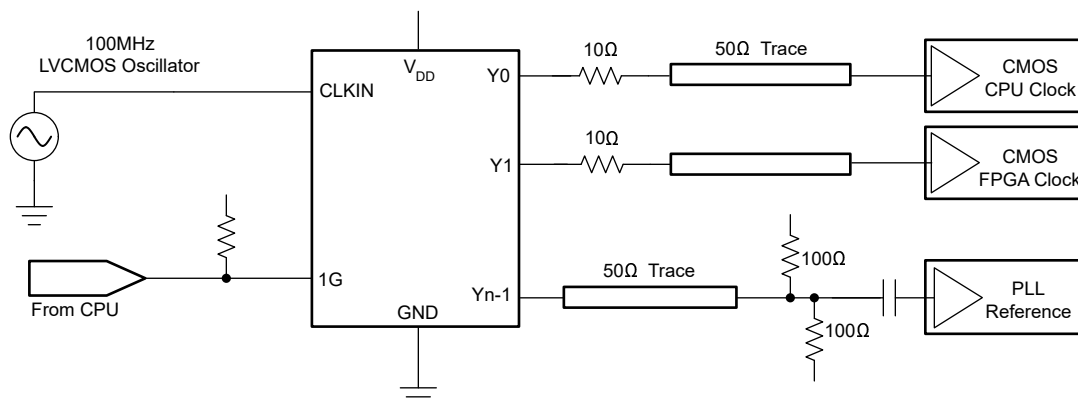


図 9-1. システム構成の例

9.2.1 設計要件

図 9-1 に示す LMK1C110x-Q1 は、ローカル LVCMOS 発振器から 100MHz の信号をファンアウトするように構成されています。CPU は、1G により出力状態を制御するように構成されています。

この構成例では、以下の特性を持つバックプレーンアプリケーションの 3 つの LVCMOS レシーバを駆動します。

- CPU クロックは、フルスイングの DC 結合 LVCMOS 信号に対応できます。反射を最小限に抑えるため、直列抵抗 R_S は LMK1C110x-Q1 の近くに配置して、トレースの特性インピーダンスと厳密に一致させます。
- FPGA クロックも同様に DC 結合され、LMK1C110x-Q1 の近くに配置される適切な直列抵抗となります。
- この例の PLL は、より低い振幅の信号を受け入れることができるため、テブナンの等価終端 (V_{DD} にプルアップし、 GND にプルダウン) を使用します。PLL レシーバは内部バイアスを備えているため、同相電圧がミスマッチしたときに AC 結合を使用できます。

9.2.2 詳細な設計手順

未使用の出力はフローティングのままにできます。推奨されるフィルタリング技法については [電源に関する推奨事項](#) を参照してください。

9.2.3 アプリケーション曲線

LMK1C110x-Q1 の追加ジッタが小さいことを、図 9-2 に示します。

図 9-3 は、25.6fs RMS ジッタを持つ低ノイズ 156.25MHz リファレンス ソースで LMK1C110x-Q1 を駆動し、3.3V 電源条件において 12kHz ~ 20MHz で積分した場合に 26.7fs RMS ジッタとなることを示しています。この設定では、結果として測定された付加ジッタは 7.6fs RMS という低い値になります。

図 9-4 は、25.6fs RMS ジッタを持つ低ノイズ 156.25MHz リファレンス ソースで LMK1C110x-Q1 を駆動し、2.5V 電源条件において 12kHz ~ 20MHz で積分した場合に 27.5fs RMS ジッタとなることを示しています。この設定では、結果として測定された付加ジッタは 10fs RMS という低い値になります。

図 9-5 は、25.6fs RMS ジッタを持つ低ノイズ 156.25MHz リファレンス ソースで LMK1C110x-Q1 を駆動し、1.8V 電源条件において 12kHz ~ 20MHz で積分した場合に 32fs RMS ジッタとなることを示しています。この設定では、結果として測定された付加ジッタは 19.2fs RMS という低い値になります。

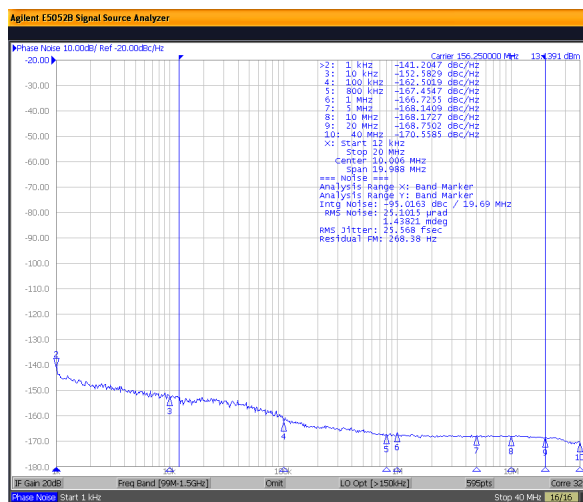


図 9-2. LMK1C110x-Q1 リファレンス位相ノイズ
25.6fs (12kHz ~ 20MHz)

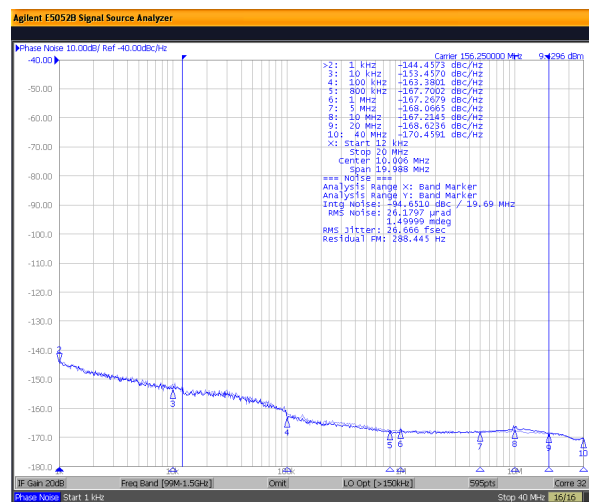


図 9-3. LMK1C110x-Q1 3.3V 出力位相ノイズ 26.7fs
(12kHz ~ 20MHz)

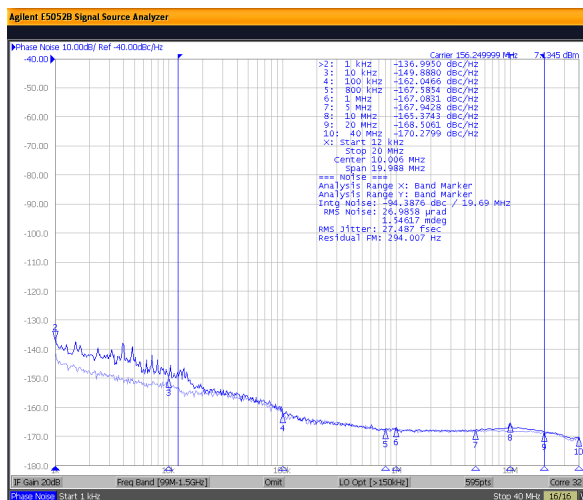


図 9-4. LMK1C110x-Q1 2.5V 出力位相ノイズ 27.5fs
(12kHz ~ 20MHz)

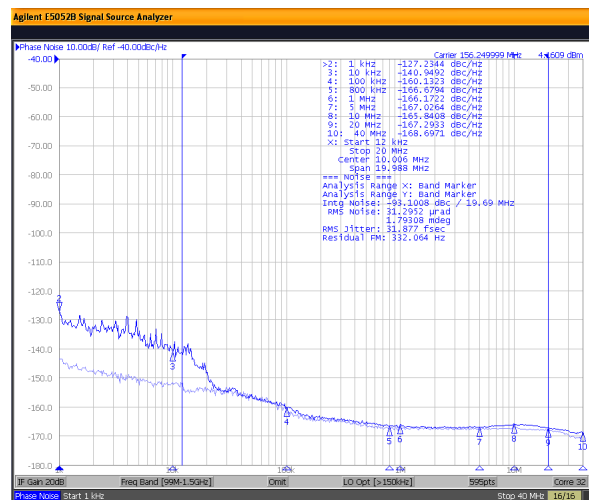


図 9-5. LMK1C110x-Q1 1.8V 出力位相ノイズ 32fs
(12kHz ~ 20MHz)

9.3 電源に関する推奨事項

高性能クロック バッファは、電源のノイズに敏感であり、バッファの付加ジッタが大幅に増加する可能性があります。そのため、特にジッタと位相ノイズの性能が重要なアプリケーションでは、システム電源からの過剰ノイズを管理することが不可欠です。

フィルタ コンデンサを使用して、電源からの低周波数ノイズを除去すると、バイパス コンデンサが高周波ノイズに対する非常に低いインピーダンス パスとして機能し、電源システムを誘導性の変動から保護できます。これらのバイパス コンデンサは、デバイスの必要に応じて瞬間的な電流サージを発生させます。またバイパス コンデンサの等価直列抵抗 (ESR) を小さくする必要があります。電源を適切にバイパスするには、デカップリング コンデンサを電源端子の近くに配置し、グランド プレーンに直接接続し、インダクタンスを最小限に抑えるために短いループでレイアウトする必要があります。TI では、パッケージの電源端子と同じ数の高周波バイパス コンデンサ (0.1 μ F 等) を追加することを推奨しています。基板電源とチップ電源の間にフェライト ビーズを挿入し、クロック バッファが生成する高周波スイッチング ノイズを絶縁することを推奨しますが、これは必須ではありません。これらのビーズは、スイッチング ノイズが基板の電源に漏れるのを防止します。基板電源とチップ電源を適切に絶縁し、適切な動作に必要な最小電圧を上回る電源端子の電圧を維持するため、DC 抵抗が非常に小さく適切なフェライト ビーズを選定します。

図 9-6 に、この推奨される電源デカップリング方法を示します。

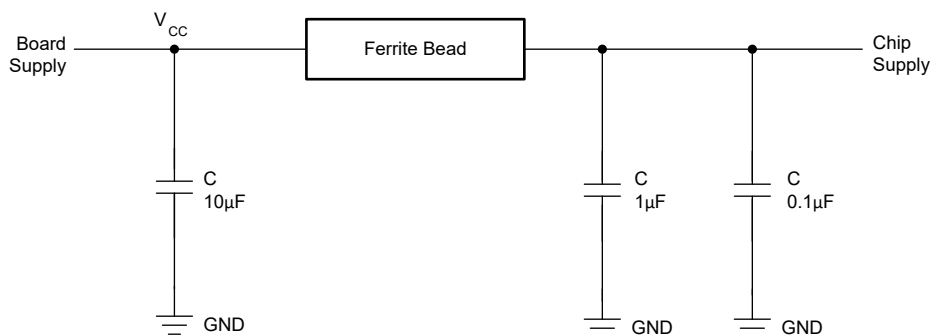


図 9-6. 電源のデカップリング

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

図 9-7 に、電源バイパス コンデンサの推奨配置を詳細に示した概念レイアウトを示します。部品側の実装には、0402 の本体サイズのコンデンサを使用して信号の配線を容易にします。バイパス コンデンサとデバイスの電源との間の接続はできる限り短くします。グランド プレーンへの低インピーダンス接続を使用して、コンデンサの反対側をグランドに接続します。

9.4.2 レイアウト例

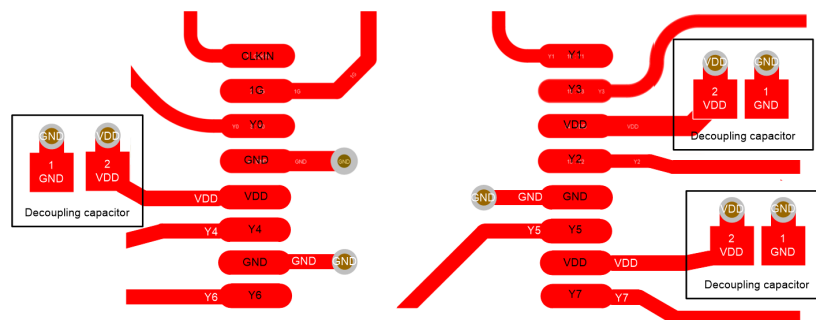


図 9-7. 14 ピンおよび 16 ピン PW デバイスのレイアウト例

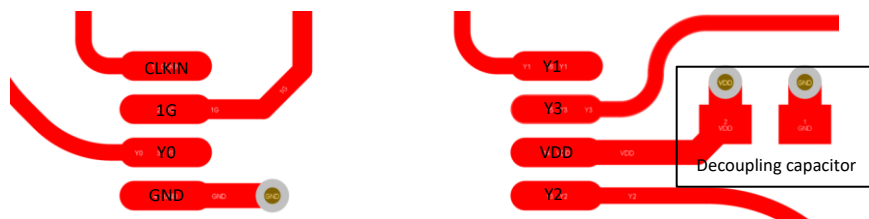


図 9-8. レイアウト例 (8 ピン PW デバイス)

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 ドキュメントのサポート

10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[LMK1C1108EVM](#)』EVM ユーザー ガイド

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ [E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
January 2026	*	初版リリース

12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

12.1 パッケージ情報

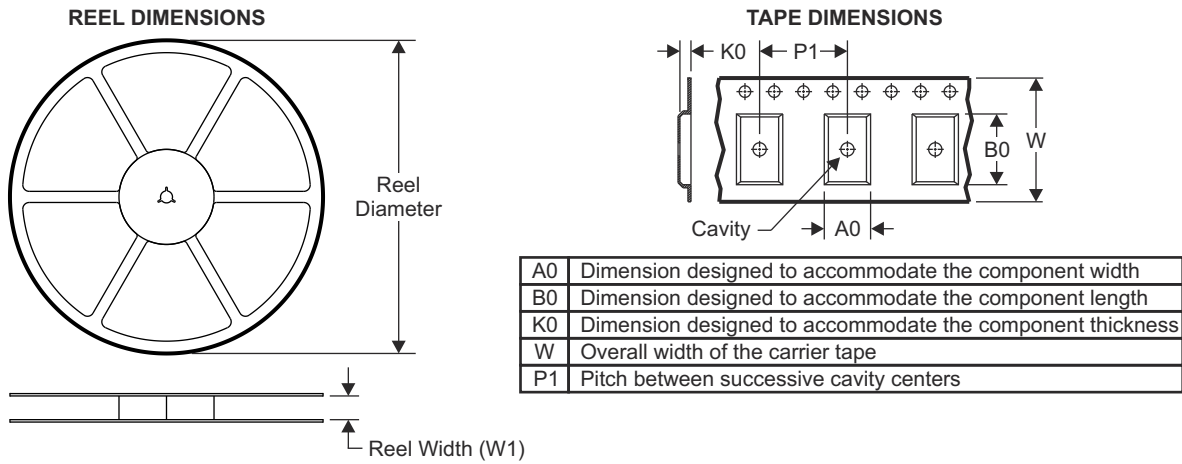
発注可能なデバイス	供給状況 ⁽¹⁾	パッケージタイプ	パッケージ図	ピン	パッケージの数量	エコ プラン ⁽²⁾	リード端子の仕上げ / ボールの原材料 ⁽⁶⁾	MSL ピーク温度 ⁽³⁾	動作温度 (°C)	デバイス マーキング ^{(4) (5)}
PLMK1C1102Q DQFRQ1	アクティブ	WSO	DQF	8	3000	RoHS & グリーン	NiPdAu	レベル-1-260C-UNLIM	-40～125	P1102Q
PLMK1C1104Q DQFRQ1	アクティブ	WSO	DQF	8	3000	RoHS & グリーン	NiPdAu	レベル-1-260C-UNLIM	-40～125	P1104Q
PLMK1C1106Q PWRQ1	アクティブ	TSSOP	PW	14	2000	RoHS & グリーン	NiPdAu	レベル-1-260C-UNLIM	-40～125	PK1C6Q
PLMK1C1108Q PWRQ1	アクティブ	TSSOP	PW	16	2000	RoHS & グリーン	NiPdAu	レベル-1-260C-UNLIM	-40～125	PK1C8Q

- (1) マーケティング ステータスの値は次のように定義されています。
供給中: 新しい設計への使用が推奨される量産デバイス。
最終受注中: TI はデバイスの生産終了を発表しており、現在最終受注期間中です。
非推奨品: 新規設計には推奨しません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、テキサス・インスツルメンツでは新規設計にこの部品を使用することを推奨していません。
開発中製品: デバイスは発表済みですが、まだ生産は開始されていません。サンプルが提供される場合と提供されない場合があります。
生産中止品: TI は、このデバイスの生産を終了しました。
- (2) **RoHS:** TI は「RoHS」を、10 種類の RoHS 物質すべてに対する現在の EU の RoHS 要件に準拠した半導体製品を意味すると定義しています。これには 10 種類のすべての RoHS 物質が同種の材質内で 0.1% を超えないという要件も含まれています。高温で半田付けするように設計された「RoHS」製品は、規定された鉛フリー プロセスでの使用に適しています。TI ではこのタイプの製品を「鉛フリー」と呼ぶことがあります。
RoHS 適用除外: TI が定義した「RoHS 適用除外」とは、鉛を含有しているが、特定の EU RoHS 免除の対象になった EU RoHS に準拠している製品を意味します。
グリーン: TI が定義した「グリーン」とは、塩素 (Cl) および臭素 (Br) をベースとした難燃材の含有量が JS709B の低ハロゲン要件である 1,000ppm 以下の閾値を満たしていることを意味します。三酸化アンチモンをベースとする難燃材も、1,000ppm 以下の閾値要件を満たす必要があります。
- (3) MSL、ピーク温度 - JEDEC 業界標準分類に従った耐湿性レベル評価、およびピークはんだ温度です。
- (4) ロゴ、ロットトレース コード情報、または環境カテゴリに関する追加マークがデバイスに表示されることがあります。
- (5) 複数のデバイス マーキングが、括弧書きされています。カッコ内に複数のデバイス マーキングがあり、「～」で区切られている場合、その中の 1 つだけがデバイスに表示されます。行がインデントされている場合は、前行の続きということです。2 行合わせたものが、そのデバイスのデバイス マーキング全体となります。
- (6) リード端子の仕上げ / ボールの原材料 - 発注可能なデバイスには、複数の材料仕上げオプションが用意されていることがあります。複数の仕上げオプションは、縦罫線で区切られています。リード端子の仕上げ / ボールの原材料の値が最大列幅に収まらない場合は、2 行にまたがります。

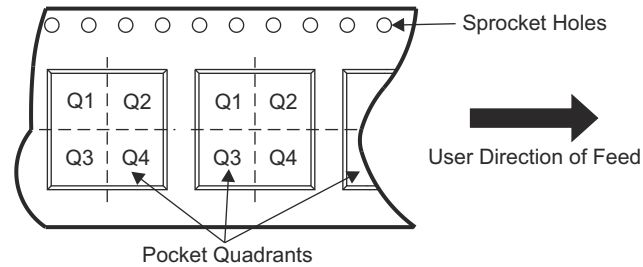
重要なお知らせと免責事項: このページに掲載されている情報は、発行日現在のテキサス・インスツルメンツの知識および見解を示すものです。テキサス・インスツルメンツの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。テキサス・インスツルメンツでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。テキサス・インスツルメンツおよび テキサス・インスツルメンツのサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

いかなる場合においても、そのような情報から生じた TI の責任は、このドキュメント発行時点での TI 製品の価格に基づく TI からお客様への合計購入価格 (年次ベース) を超えることはありません。

12.2 テープおよびリール情報

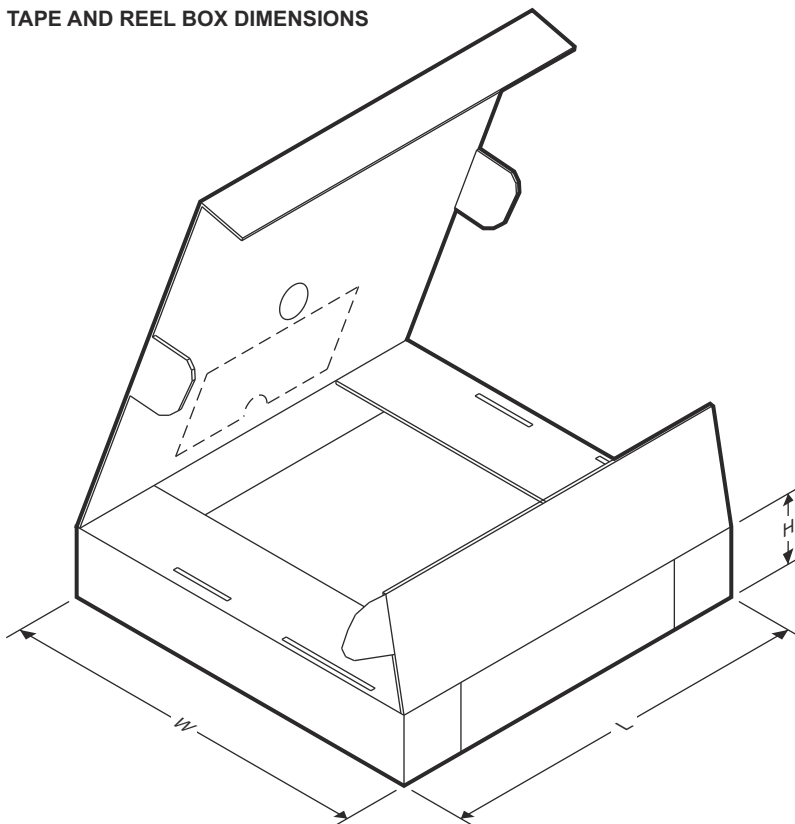


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



デバイス	パッケージ タイプ	パッケージ 図	ピン	SPQ	リール 直径 (mm)	リール 幅 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	ピン 1 の 象限
PLMK1C1102QDQFRQ 1	WSOP	DQF	8	3000	178	8.4	2.25	2.25	1.0	4	8	Q2
PLMK1C1104QDQFRQ 1	WSOP	DQF	8	3000	178	8.4	2.25	2.25	1.0	4	8	Q2
PLMK1C1106QPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	330	12.4	6.9	5.6	1.6	8	12	Q1
PLMK1C1108QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	330	12.4	6.9	5.6	1.6	8	12	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



デバイス	パッケージタイプ	パッケージ図	ピン	SPQ	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
PLMK1C1102QDQFRQ1	WSON	DQF	8	3000	205	200	33
PLMK1C1104QDQFRQ1	WSON	DQF	8	3000	205	200	33
PLMK1C1106QPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	356	356	35
PLMK1C1108QPWRQ1	TSSOP	PW	16	2000	356	356	35

ADVANCE INFORMATION

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月